

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年4月7日(2011.4.7)

【公開番号】特開2008-252072(P2008-252072A)

【公開日】平成20年10月16日(2008.10.16)

【年通号数】公開・登録公報2008-041

【出願番号】特願2008-40843(P2008-40843)

【国際特許分類】

H 01 L 21/3205 (2006.01)

H 01 L 23/52 (2006.01)

H 01 L 21/288 (2006.01)

H 01 L 27/10 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/88 A

H 01 L 21/288 Z

H 01 L 27/10 4 3 1

【手続補正書】

【提出日】平成23年2月18日(2011.2.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

導電性材料よりなるナノ粒子が溶媒に分散された組成物を吐出し、

前記組成物を乾燥し、

前記乾燥により溶媒を気化させた組成物にオゾン雰囲気下で紫外線を照射した後、焼成して配線を形成することを特徴とする配線の作製方法。

【請求項2】

請求項1において、

前記紫外線の波長は175nm以下であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項3】

導電性材料よりなるナノ粒子が溶媒に分散された組成物を吐出し、

前記組成物を乾燥し、

前記乾燥により溶媒を気化させた組成物に空気中で波長175nm以下の紫外線を照射した後、焼成して配線を形成することを特徴とする配線の作製方法。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一項において、

前記組成物を、配線形成領域以外に形成された隔壁の内側に吐出することを特徴とする配線の作製方法。

【請求項5】

請求項1または請求項4において、

前記紫外線を、低圧水銀ランプを用いて照射することを特徴とする配線の作製方法。

【請求項6】

請求項1乃至請求項4のいずれか一項において、

前記紫外線を、エキシマランプを用いて照射することを特徴とする配線の作製方法。

【請求項7】

第1の導電層を形成し、  
前記第1の導電層上にメモリ層を形成し、  
前記メモリ層上に、導電性材料よりなるナノ粒子が溶媒に分散された組成物を吐出し、  
前記組成物を乾燥し、  
前記乾燥により溶媒を気化させた組成物にオゾン雰囲気下で紫外線を照射した後、焼成して第2の導電層を形成することを特徴とする記憶素子の作製方法。

【請求項8】

請求項7において、

前記紫外線の波長は175nm以下であることを特徴とする記憶素子の作製方法。

【請求項9】

第1の導電層を形成し、

前記第1の導電層上にメモリ層を形成し、

前記メモリ層上に、導電性材料よりなるナノ粒子が溶媒に分散された組成物を吐出し、  
前記組成物を乾燥し、

前記乾燥により溶媒を気化させた組成物に空気中で波長175nm以下の紫外線を照射した後、焼成して第2の導電層を形成することを特徴とする記憶素子の作製方法。

【請求項10】

請求項7乃至請求項9のいずれか一項において、

前記メモリ層は有機化合物層であることを特徴とする記憶素子の作製方法。